

## 产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,  
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

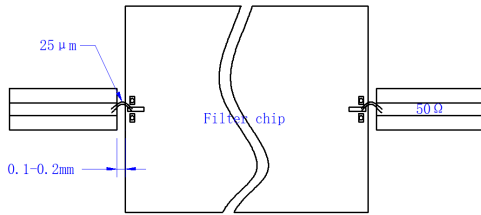
## 主要参数

| 参数   | 频率          | /    | 最小    | 典型  | 最大    | 单位  |
|------|-------------|------|-------|-----|-------|-----|
| 通带频率 | /           | /    | 15900 | ~   | 17200 | MHz |
| 中心损耗 | /           | /    |       | 3.9 |       | dB  |
| 带内波动 | /           | /    |       |     | 1.3   | dB  |
| 带外抑制 | 14.85&18.25 | GHz≥ | 30    |     |       | dB  |
| 带外抑制 | 14.75&18.4  | GHz≥ | 40    |     |       | dB  |
| 带外抑制 | DC-14.65    | GHz≥ | 50    |     |       | dB  |
| 带外抑制 | 18.9-35.0   | GHz≥ | 50    |     |       | dB  |
| 通带驻波 | /           | /    |       |     | 1.8   |     |

## 其它参数

|       |               |
|-------|---------------|
| 接口形式  | 微带焊盘          |
| 阻抗    | 50Ω           |
| 功率容量  | 35dBm设计保证     |
| 时延波动  | ≤0.6ns        |
| 相位一致性 | ≤±5°          |
| 工作温度  | -55~+85℃设计保证  |
| 存储温度  | -55~+125℃设计保证 |
| 质量等级  | 工业级           |
| ROHS  | 满足            |
| 滤波器类别 | MEMS          |

## 装配示意图



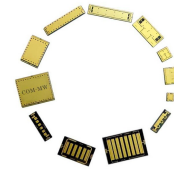
## 装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用50μm×10μm的金带或2根25μm的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

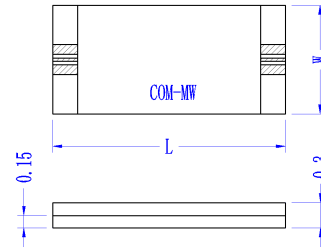
## 建议PCB布局图

| ER:2.2 H:0.254mm         | ER:2.2 H:0.254mm       |
|--------------------------|------------------------|
|                          |                        |
| Frequency range 10-20GHz | Frequency range >20GHz |

## 参考实物图



## 外形结构图 (mm)



| 尺寸代码 | 最小值 (mm) | 标称值 (mm) | 最大值 (mm) |
|------|----------|----------|----------|
| L    | 3.4      | 3.5      | 3.6      |
| W    | 2.1      | 2.2      | 2.3      |

## 典型测试曲线图

